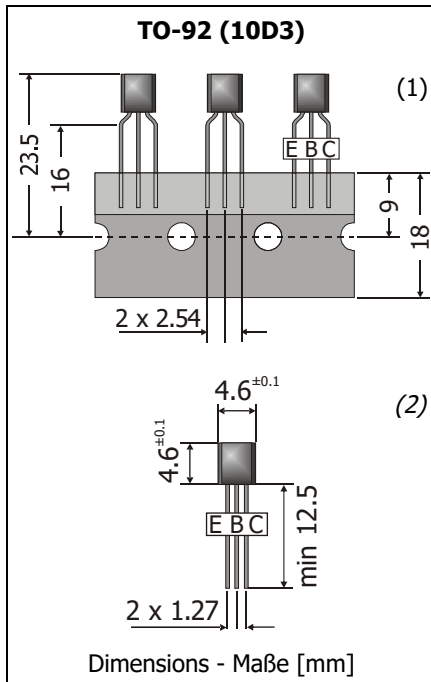


<b>MPSA92</b> <b>High Voltage PNP Transistors</b> <b>Hochspannungs-PNP-Transistoren</b>	<b>I<sub>C</sub> = - 500 mA</b> <b>h<sub>FE1</sub> &gt; 40</b> <b>T<sub>jmax</sub> = 150°C</b>	<b>V<sub>CEO</sub> = - 300 V</b> <b>P<sub>tot</sub> = 625 mW</b>
---	--	---

Version 2017-11-21



**Typical Applications**

Signal processing,  
Switching, Amplification  
Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

High collector voltage  
Compliant to RoHS, REACH,  
Conflict Minerals <sup>1)</sup>



**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000
Weight approx.	0.18 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,  
Schalten, Verstärken  
Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Hohe Kollektorspannung  
Konform zu RoHS, REACH,  
Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)	4000
(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")	5000
Gewicht ca.	0.18 g
Gehäusematerial	UL 94V-0
Löt- und Einbaubedingungen	260°C/10s MSL N/A

<b>Recommended complementary NPN transistors</b> <b>Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren</b>	MPSA42
--	--------

**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

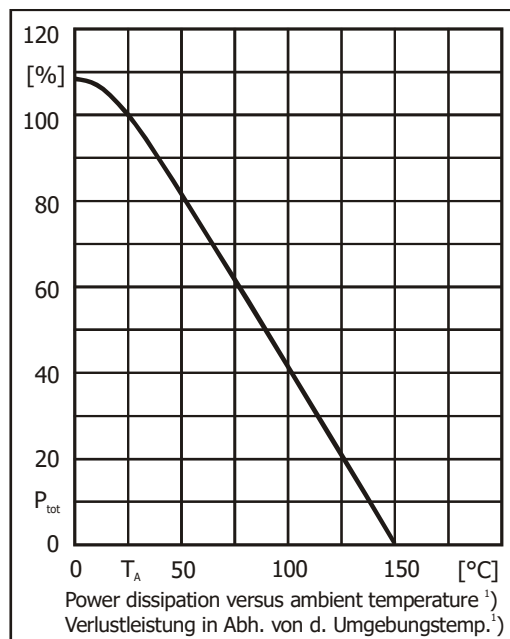
**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V <sub>CEO</sub>	300 V
Collector-Base-voltage Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V <sub>CBO</sub>	300 V
Emitter-Base-voltage Emitter-Basis-Spannung	C open	- V <sub>EBO</sub>	5 V
Power dissipation Verlustleistung		P <sub>tot</sub>	625 mW <sup>3)</sup>
Collector current Kollektorstrom	DC	- I <sub>C</sub>	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>j</sub> T <sub>s</sub>	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
2 T<sub>A</sub> = 25°C, unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C, wenn nicht anders angegeben  
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
$I_E = 0, V_{CB} = -200\text{ V}$	$-I_{CB0}$	–	–	–	250 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom					
$I_B = 0, V_{EB} = -3\text{ V}$	$-I_{EB0}$	–	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>					
$-I_C = 20\text{ mA}, -I_B = 2\text{ mA}$	$-V_{CEsat}$	–	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>4)</sup>					
$-I_C = 20\text{ mA}, -I_B = 2\text{ mA}$	$-V_{BEsat}$	–	–	–	0.9 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>					
$-V_{CE} = 10\text{ V}$	$h_{FE}$	25	–	–	–
$-I_C = 1\text{ mA}$		40	–	–	–
$-I_C = 30\text{ mA}$		25	–	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$-V_{CE} = 20\text{ V}, -I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	$f_T$	–	70 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
$-V_{CB} = 20\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$	$C_{CB0}$	–	–	–	7 pF
Thermal resistance junction – ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	$R_{thA}$	$< 200\text{ K/W}^2)$			



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)

**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$   
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden